

<p>NPN型 低频放大 小功率 贴片三极管 NPN Plastic-Encapsulate Transistors SMD</p>	<p>HS8050, HS8050A HM8050, HMBT8050 HSS8050, HMC6802 对应其他工业型号 S8050, SS8050 MMBT8050LT1</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ High breakdown voltage ■ Low collector-emitter saturation voltage ■ Complementary to HMBT8550 ■ Transistor Polarity: NPN ■ Transistor pinout: BEC ■ SOT-23 Package ■ Marking Code: J3Y 	

<p>Inner circuit</p>  <p>SOT-23 内部结构</p>	<p>8050 Series</p>  <p>SOT-23 管脚排列</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Base 2. Emitter 3. Collector 	<p>元件标识 (打印)</p>  <p>DEVICE MARKING</p>
---	---	--

DEVICE MARKING 元件标识 (打印)				CLASSIFICATION OF hFE			
型号	MARKING	型号	MARKING	Rank	L	H	J
S8050	J3Y	M8050	Y1.	Range	120~200	200~350	300~400
S8050A	J3Y.	SS8050	Y.1	细分 hFE RANGE 放大倍数分档	(85~150), (120~220) (200~300), (280~400)		
HMC6802	6802	MMBT8050	Y1				

■ MAXIMUM RATINGS 最大额定值

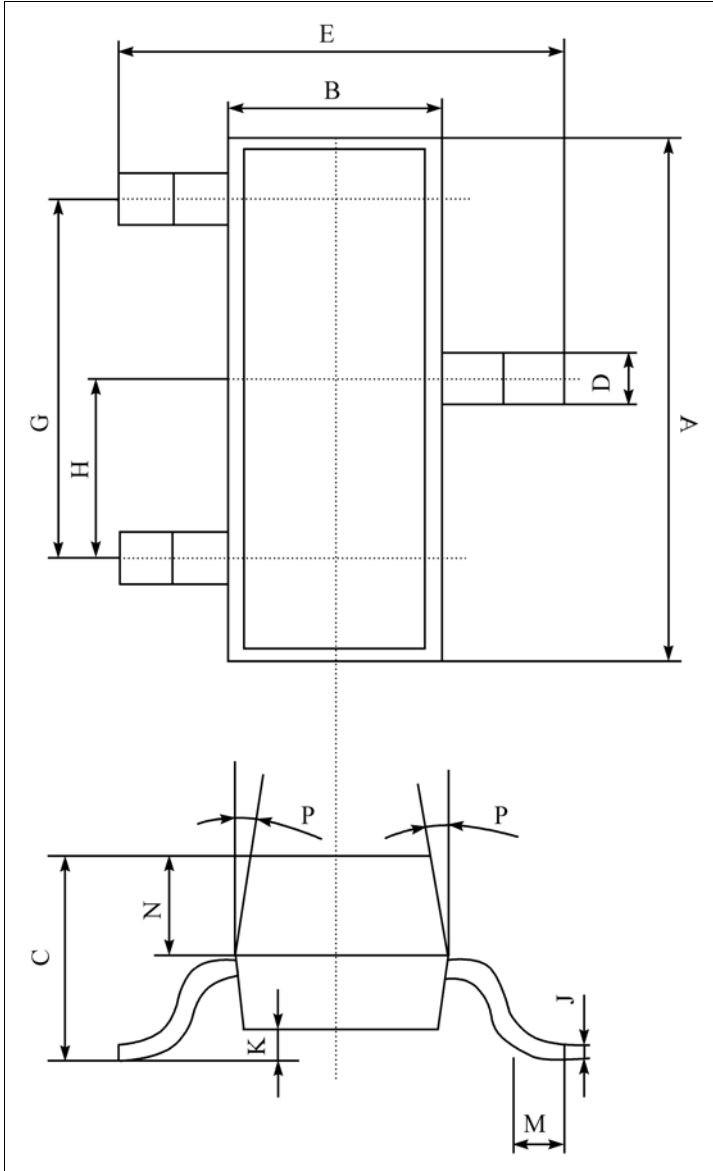
Characteristic 特性参数		Symbol 符号	Rating 额定值	Unit 单位
Collector-Emitter Voltage 集电极-发射极电压	HS8050	V_{CEO}	25	V
	HMC6802		18	
Collector-Base Voltage 集电极-基极电压	HS8050	V_{CBO}	40	
	HMC6802		25	
Emitter-Base Voltage 发射极-基极电压		V_{EBO}	5.0	
Collector Current -Continuous 集电极电流-连续	HS8050, HS8050A	I_C	500	mA
	HM8050		1000	
	HMBT8050		1200	
	HSS8050		1500	
	HMC6802		1800	
Total Device Dissipation 耗散功率		P_D	225	mW
Junction Temperature 结温		T_j	150	°C
Storage Temperature Range 储存温度		T_{stg}	-55~+150	

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性 ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)

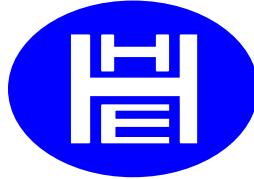
Characteristic 特性参数	Test Condition 测试条件	Symbol 符号	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 单位
Collector Cutoff Current 集电极截止电流	$V_{CB}=300\text{V}, I_E=0$	I_{CBO}	--	--	0.1	μA
Emitter Cutoff Current 发射极截止电流	$V_{EB}=5\text{V}, I_C=0$	I_{EBO}	--	--	0.1	
Collector-Base Breakdown Voltage 集电极-基极击穿电压	$I_E=0$ $I_C=100\mu\text{A}$	HS8050	40	--	--	V
		HMC6802	25	--	--	
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极-发射极击穿电压	$I_E=0$ $I_C=10\text{mA}$	HS8050	25	--	--	
		HMC6802	18	--	--	
Emitter Cutoff Current 发射极-基极击穿电压	$I_C=0, I_E=100\mu\text{A}$	$V_{(BR)EBO}$	5	--	--	
DC Current Gain 直流电流增益	$I_C=100\text{mA}, V_{CE}=1\text{V}$		$h_{FE} (1)$	85	--	400
	$I_C=500\text{mA}$	HS8050	$h_{FE} (2)$	40	--	--
HS8050A		30		--	--	
DC Current Gain 直流电流增益	$I_C=800\text{mA}$	HM8050		40	--	--
		HMBT8050		40	--	--
		HSS8050		40	--	--
$I_C=1800\text{mA}$	HMC6802	50		--	--	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极-发射极饱和压降	$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}$	$V_{CE(sat)}$	--	--	0.6	V
Base-Emitter Voltage 基极-发射极电压	$V_{CE}=1\text{V}, I_C=10\text{mA}$	$V_{CE(sat)}$	--	0.8	1.0	
Current-Gain-Bandwidth Product 电流增益-带宽乘积	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=10\text{mA}$	f_T	100	120	--	MHz
Collector Output Capacitance 输出电容	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	C_{ob}	--	13	30	pF

■ DIMENSION 外形封装尺寸数据 (Package: SOT-23 HAOHAI Package Code: MM)

单位 (UNIT) : mm



序号	数值及公差
A	2.90±0.10
B	1.30±0.10
C	1.00±0.10
D	0.40±0.10
E	2.40±0.20
G	1.90±0.10
H	0.95±0.05
J	0.13±0.05
K	0.00-0.10
M	≥0.20
N	0.60±0.10
P	7±2°
<p>Packing SOT-23 包装规格 SMD片式表面贴封装 包装方式: 载带卷盘包装 Tape & Reel, 3Kpcs/Reel 每卷数量3000只 (3Kpcs/Reel) 每盒数量30000只 (30Kpcs/BOX) 每箱数量300000只 (300Kpcs/Cartons)</p>	



经中华人民共和国工商行政管理总局商标局批准
HAOHAI、HHE 图案、字母、均为我公司正式注册商标，仿冒、盗用均属侵权，违法必究！

深圳市浩海电子有限公司

SHENZHEN HAOHAI ELECTRONICS CO., LTD.

2 floor(whole floor), BAOXIN Building. 0 Lane on the 8th. Yufeng Garden.
82 District. BAOAN District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

中国 广东省 深圳市 宝安区 82区 裕丰花园 零巷8号 宝馨楼 二楼 (全层)

公司电话 TEL: +86-755-29955080、29955081、29955082、29955083
总机八线 29955090、29955091、29955092、29955093

FAX: +86-755-27801767

E-mail: kkg@kkg.com.cn

产品主页 <http://www.szhhe.com>

<http://www.kkg.com.cn>